

BAS70

肖特基二极管芯片(4 ")

■用途:

高速开关应用
电路保护
电压箝位

■特征:

- * 正向压降小
- * 结电容小
- * 适用于片式封装
- * 有效图形数 133600 只

■芯片示意图



■芯片结构

芯片尺寸	230 μ m×230 μ m
压焊区尺寸	120 μ m×120 μ m
锯片槽宽度	40 μ m
芯片厚度	180±20 μ m
金属层	正面:Al 2.3±0.2μm 背面:Au 1.4±0.2μm

■电特性(Ta=25℃)

参数名称	符号	测试条件	最小	最大	典型值	单位
正向压降	V _{F1}	I _F =1mA		0.41	0.34	V
	V _{F2}	I _F =15mA		0.95	0.68	V
反向击穿电压	V _R	I _R =10 μ A	70		75	V
反向漏电流	I _R	V _R =50V		0.1		μ A
结电容	C _j	V _R =1V,f=1MHZ		2		PF
反向恢复时间	t _{rr}	I _F =I _R =10mA,R _L =100 Ω ,I _{RR} =1mA		5		ns